## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-303015

(43)Date of publication of application: 31.10.2001

(51)Int.Cl.

C09J171/02 C09J 7/00 C09J179/08 H01B 1/22 H01B 1/24

(21)Application number : 2000-128934

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

25.04.2000

(72)Inventor: SATO KAZUYA

TAKEDA SHINJI

# (54) ADHESIVE FILM, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND METHOD FOR BONDING (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an adhesive film capable of carrying out bonding at a lower temperature than that of a conventional adhesive film for die bonding and to provide a method for producing the adhesive film and a method for bonding.

SOLUTION: This adhesive film comprises (A) an oxetane compound and (B) a curing agent. The method for producing the adhesive film comprises mixing respective components containing one or more selected from (C) a polyimide resin, (D) an electroconductive filler and/or (E) an insulating filler and (F) a solvent and the oxetane compound (A) and the curing agent (B), preparing a pasty or a varnishlike mixture, applying the resultant mixture onto a base film, heating and drying the applied mixture and forming the adhesive film. The method for bonding comprises sandwiching the adhesive film between a semiconductor element and a supporting member, carrying out the thermocompression bonding and bonding the semiconductor element to the supporting member.

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-303015

(P2001-303015A)

(43)公開日 平成13年10月31日(2001,10,31)

		(43)公開日	平成13年10月31日(2001.10.31)
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	デーマコート*(参考)
C 0 9 J 171/02		C 0 9 J 171/02	4 J 0 0 4
7/00		7/00	4 J 0 4 0
179/08		179/08	Z 5G301
H01B 1/22		H01B 1/22	D
1/24		1/24	D
		審查請求未請求	請求項の数12 OL (全 17 頁)
(21)出願番号	特願2000-128934(P2000-128934)	(71)出顧人 000004455	5
		日立化成	工業株式会社
(22)出顧日	平成12年4月25日(2000.4.25)	東京都新	官区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者 佐藤 和	<u>tt</u>
		茨城県つ・	くば市和台48 日立化成工業株式
		会社総合	研究所内
		(72)発明者 武田 信	<b>i</b> j
		茨城県つぐ	くば市和台48 日立化成工業株式
		会社総合研	研究所内
			mi Alicerta il Ada
			最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 接着フィルム、その製造方法及び接着方法

### (57)【要約】

【課題】 接着時の接着温度を従来のダイボンド用接着フィルムよりもさらに低温で行うことのできる、接着フィルム、その製造方法及び接着方法を提供する。

【解決手段】 オキセタン化合物(A)、硬化剤(B)を含む接着フィルム。ポリイミド樹脂(C)、導電性フィラー(D)及び/または絶縁性フィラー(E)、溶媒(F)から選ばれる1以上とオキセタン化合物(A)及び硬化剤(B)を含む各成分を混合しペースト状またはワニス状の混合物を作製し、これをベースフィルム上に塗布し、加熱・乾燥して接着フィルムを形成する接着フィルムの製造方法。半導体素子と支持部材の間に上記接着フィルムを挟み、加熱圧着して半導体素子と支持部材とを接着する接着方法。

【特許請求の範囲】

オキセタン化合物(A)、硬化剤(B) 【請求項1】 を含む接着フィルム。

1

さらにポリイミド樹脂(C)を含む請求 【請求項2】 項1に記載の接着フィルム。

ポリイミド樹脂 (C) が一般式 (1) で\* 【請求項3】

(ただし、 $n=2\sim20$ の整数を示す。)

【請求項4】 さらに導電性フィラー(D)及び/また は絶縁性フィラー (E) を含む請求項1ないし請求項3 のいずれかに記載の接着フィルム。

【請求項5】 オキセタン化合物(A)100重量部に 対し、導電性フィラー(D)0~8000重量部及び/ または絶縁性フィラー(E)0~8000重量部の割合 で含む請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の接着 フィルム。

【請求項6】 硬化剤(B)が、オキセタン化合物 (A) を開環重合させる硬化剤(B')であり、カチオ ン重合性触媒、アニオン重合性触媒、潜在性カチオン重 合開始剤、潜在性アニオン重合性触媒から選ばれる1以 上である請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の接 着フィルム。

【請求項7】 硬化剤(B')が潜在性カチオン重合開 始剤(B1)である請求項6に記載の接着フィルム。

【請求項8】 硬化剤(B)が、オキセタン化合物

(A)と付加反応する硬化剤(B")であり、2官能以 上のカルボン酸、2官能以上のポリチオール、2官能以 上のカルボン酸無水物、2官能以上のフェノール化合物 から選ばれる1つ以上である請求項1ないし請求項5の いずれかに記載の接着フィルム。

【請求項9】 硬化剤(B")が、フェノール化合物 (B2)である請求項8に記載の接着フィルム。

【請求項10】 請求項1ないし請求項9のいずれかに 記載のポリイミド樹脂(C)、導電性フィラー(D)及 び/または絶縁性フィラー(E)、溶媒(F)から選ば れる1以上とオキセタン化合物(A)及び硬化剤(B) を含む各成分を混合しペースト状またはワニス状の混合 40 物を作製し、これをベースフィルム上に塗布し、加熱・ 乾燥して接着フィルムを形成する接着フィルムの製造方 法。

【請求項11】 半導体素子と支持部材の間に請求項1 ないし請求項9のいずれかに記載の接着フィルムを挟 み、加熱圧着することを特徴とする半導体素子と支持部 材との接着方法。

【請求項12】 活性光線を接着フィルムに照射するこ とを特徴とする請求項11に記載の半導体素子と支持部 材との接着方法。

\* 表されるテトラカルボン酸二無水物の含量が全テトラカ ルボン酸二無水物(C')の70モル%以上であるテト ラカルボン酸二無水物と、ジアミン(C")を反応させ て得られるポリイミド樹脂 (C) である請求項2に記載 の接着フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ICやLSI等の 半導体素子とリードフレームや絶縁性支持基板等支持部 材との接合材料、すなわちダイボンディング用材料とし て用いられる接着フィルム、その製造方法及び接着方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ICやLSIとリードフレームの 20 接合にはAu-Si共晶合金、半田あるいは銀ペースト 等が用いられている。Au-Si共晶合金は、耐熱性及 び耐湿性は高いが、弾性率が大きいため大型チップへ適 用した場合に割れやすいほか、高価である難点がある。 半田は安価であるものの、耐熱性が劣り、更に弾性率は Au-Si共晶合金と同様に高く、大型チップへ適用が 困難である。一方、銀ペーストは安価で、耐湿性が高 く、弾性率も上記3者の中では最も低く、350℃の熱 圧着型ワイヤボンダーに適用できる耐熱性も有するの で、現在は、ICやLSIとリードフレームの接着用材 料の主流である。しかし、近年ICやLSIの高集積化 が進み、それに伴ってチップが大型化している中で、Ⅰ CやLSIとリードフレームを銀ペーストで接合しよう とする場合、銀ペーストをチップ全面に広げ塗布するに は困難を伴う。

【0003】マイクロエレクトロニック マニュファク チャリング アンド テスティング(MICROELECTRONIC M ANUFACTURING AND TESTING 1985年10月)に、導電 性フィラーを熱可塑性樹脂に充填したダイボンド用の接 着フィルムが報告された。これは熱可塑性樹脂の融点付 近まで温度を上げ、加圧接着するものである。

【0004】また、本発明者らは、先に、特定のポリイ ミド樹脂を用いた接着フィルム及びこれに導電性フィラ ーもしくは無機フィラーを含有するダイボンド用接着フ ィルムを提案した(特開平6-145639号、特開平 7-228697号、特開平10-330723号公報 他)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】前記マイクロエレクト ロニック マニュファクチャリング アンド テスティ 50 ングで報告された接着フィルムは、融点の低い熱可塑性

\* 法及び接着方法を提供するものである。

樹脂を選んで用いると接着温度を低くすることができ、 リードフレームの酸化等、チップに与えるダメージは少 なくてすむが、熱時接着力が低いのでダイボンド後の熱 処理(例えばワイヤボンド、封止工程等)に耐えられな い。熱処理に耐えられる融点の高い熱可塑性樹脂を用い ると、接着温度が高くなり、リードフレームが酸化等の ダメージを受けやすい。

【0006】本発明者らが先に提案した接着フィルム は、比較的低温で接着でき、かつ良好な熱時接着力をも っている。しかし、近年使われ始めている銅リードフレ ーム(酸化を受けやすい)や熱伝導性の低い絶縁性支持 基板 (熱膨張が大きいため、加熱接合時に反りやすい) への接合には、更に低い温度で接着できる接着フィルム が強く望まれている。本発明は、接着時の接着温度を従 来のダイボンド用接着フィルムよりもさらに低温で行う ことのできる、ダイボンド用接着フィルム、その製造方\* [0007]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 オキセタン化合物(A)、硬化剤(B)を含む接着フィ ルムであり、低温接着性に優れ、42アロイリードフレ ームや銅リードフレームにも好適に使用でき、更に絶縁 性支持基板にも好適に使用できる接着フィルムを提供す るものである。請求項2記載の発明は、さらにポリイミ ド樹脂(C)を含む請求項1に記載の接着フィルムであ り、請求項3に記載の発明は、ポリイミド樹脂 (C) が 一般式(1)で表されるテトラカルボン酸二無水物の含 量が全テトラカルボン酸二無水物(C')の70モル% 以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミン (C")を反応させて得られるポリイミド樹脂(C)で ある請求項2に記載の接着フィルムである。 【化2】

(1)

(ただし、 $n=2\sim20$ の整数を示す。) 請求項2、3の発明は、請求項1記載の発明の効果に加 えてせん断接着力に優れる接着フィルムを提供するもの である。

【0008】請求項4に記載の発明は、さらに導電性フ ィラー(D)及び/または絶縁性フィラー(E)を含む 請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の接着フィル ムである。請求項5に記載の発明は、オキセタン化合物 (A) 100重量部に対し、導電性フィラー (D) 0~ 8000重量部及び/または絶縁性フィラー(E)0~ 8000重量部の割合で含む請求項1ないし請求項4の いずれかに記載の接着フィルムである。請求項4、5記 載の発明は、請求項1~3記載の発明の効果に加えて熱 膨張係数の異なる基材同士の接着に優れる接着フィルム を提供するものである。請求項6に記載の発明は、硬化 剤(B)が、オキセタン化合物(A)を開環重合させる 硬化剤(B')であり、カチオン重合性触媒、アニオン 重合性触媒、潜在性カチオン重合開始剤、潜在性アニオ ン重合性触媒から選ばれる1以上である請求項1ないし 請求項5のいずれかに記載の接着フィルムである。請求 40 項7に記載の発明は、硬化剤(B')が潜在性カチオン 重合開始剤(B1)である請求項6に記載の接着フィル ムである。請求項6、7記載の発明は、請求項1~5記 載の発明の効果に加えて保存安定性に優れる接着フィル ムを提供するものである。請求項8に記載の発明は、硬 化剤(B)が、オキセタン化合物(A)と付加反応する 硬化剤(B")であり、2官能以上のカルボン酸、2官 能以上のポリチオール、2官能以上のカルボン酸無水 物、2官能以上のフェノールから選ばれる1つ以上であ る請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の接着フィ

ルムである。請求項9に記載の発明は、硬化剤 (B") がフェノール化合物(B2)である請求項8に記載の接 着フィルムである。

【0009】請求項8、9記載の発明は、請求項1~5 記載の発明の効果に加えて高い接着信頼性を付与できる 接着フィルムを提供するものである。請求項10に記載 の発明は、請求項1ないし請求項9のいずれかに記載の ポリイミド樹脂(C)、導電性フィラー(D)及び/ま たは絶縁性フィラー(E)、溶媒(F)から選ばれる1 以上とオキセタン化合物(A)及び硬化剤(B)を含む 各成分を混合しペースト状またはワニス状の混合物を作 製し、これをベースフィルム上に塗布し、加熱・乾燥し て接着フィルムを形成する接着フィルムの製造方法であ り、接着フィルムの製造方法を提供するものである。請 求項11に記載の発明は、半導体素子と支持部材の間に 請求項1ないし請求項9のいずれかに記載の接着フィル ムを挟み、加熱圧着することを特徴とする半導体素子と 支持部材との接着方法である。請求項12に記載の発明 は、活性光線を接着フィルムに照射することを特徴とす る請求項11に記載の半導体素子と支持部材との接着方 法である。請求項11、12記載の発明は、請求項1~ 9記載の接着フィルムを用いた、半導体素子と支持部材 の接着方法を提供するものである。

#### [0010]

50

【発明の実施の形態】以下、本発明における接着フィル ム、その製造方法及び接着方法について説明する。本発 明におけるオキセタン化合物(A)は、その分子中にオ キセタン環を有していれば特に制限はなく、いかなる化 合物も用いることができる。これらの内、その分子中に 1~4個のオキセタン環を有しているオキセタン化合物

(4)

5

t、接着後にひび割れが起こりにくい点から好ましい。 【0011】1個のオキセタン環を有する化合物として t、下記一般式(2)で示される化合物等が挙げられる。

[0012] [化3]

$$R^{1} \longrightarrow C \longrightarrow R^{2}$$
(2)

【0013】一般式(2)において、R<sup>1</sup>は、水素原 子、メチル基、エチル基、プロピル基或いはブチル基等 の炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のフルオロ アルキル基、アリル基、アリール基、フリル基又はチエ ニル基である。R<sup>2</sup>は、水素原子、メチル基、エチル 基、プロピル基或いはブチル基等の炭素数1~6のアル キル基、1ープロペニル基、2ープロペニル基、2ーメ チルー1ープロペニル基、2ーメチルー2ープロペニル 基、1ープテニル基、2ープテニル基或いは3ープテニ ル基等の炭素数2~6のアルケニル基、フェニル基、ベ 20 ンジル基、フルオロベンジル基、メトキシベンジル基或 いはフェノキシエチル基等の芳香環を有する基、エチル カルボニル基、プロピルカルボニル基或いはブチルカル ボニル基等の炭素数2~6のアルキルカルボニル基、エ トキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基或いはブ トキシカルボニル基等の炭素数2~6のアルコキシカル ボニル基、又はエチルカルバモイル基、プロピルカルバ モイル基、ブチルカルバモイル基或いはペンチルカルバ モイル基等の炭素数2~6のN-アルキルカルバモイル 基等である。

【0014】つぎに、2個のオキセタン環を有する化合物としては、下記一般式(3)で示される化合物等が挙げられる。

[0015]

[化4]

【0021】一般式 (5) において、R<sup>5</sup>は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、

【化7】

NH、SO、SO2、C(CF<sub>3</sub>)2又はC(CH<sub>3</sub>)2である。

[0022]

[化8]

$$R^1$$
 (3)

【0016】一般式(3)において、R<sup>1</sup>は、前記一般式(2)におけるものと同様の基である。R<sup>3</sup>は、例えば、エチレン基、プロピレン基或いはブチレン基等の線状或いは分枝状アルキレン基、ポリ(エチレンオキシ)基或いはポリ(プロピレンオキシ)基等の線状或いは分枝状ポリ(アルキレンオキシ)基、プロペニレン基、メチルプロペニレン基或いはブテニレン基等の線状或いは分枝状不飽和炭化水素基、カルボニル基、カルボニル基を含むアルキレン基、カルボキシル基を含むアルキレン基又はカルバモイル基を含むアルキレン基等である。【0017】また、R<sup>3</sup>は、下記一般式(4)~(15)で示される基から選択される多価基でもある。【0018】

【化5】

$$-CH_2 - CH_2 -$$

【0019】一般式(4)において、R<sup>4</sup>は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基或いはブチル基等の炭素数1~4のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基或いはブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基、塩素原子或いは臭素原子等のハロゲン原30子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アルキルカルボキシル基、カルボキシル基、又はカルバモイル基である。

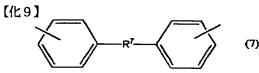
[0020] 【化6】

(5)

【0023】一般式(6)において、R<sup>6</sup>は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基或いはブチル基等の炭素数1~4個のアルキル基、メトキシ基、エトキシ 50 基、プロポキシ基或いはブトキシ基等の炭素数1~4個

のアルコキシ基、塩素原子或いは臭素原子等のハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アルキルカルボキシル基、カルボキシル基、又はカルバモイル基である。

[0024]

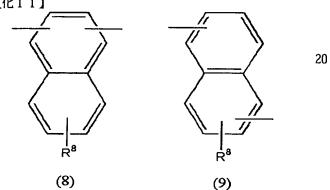


【0025】一般式(7)において、R<sup>1</sup>は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、

【化10】NH、SO、SO2、C(CF3)2又はC(CH3)2、C(C6H5)(CH3)、C(C6H5)2である。

[0026]

【化11】



8

【0027】一般式(8)及び一般式(9)において、R<sup>®</sup>は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基或いはブチル基等の炭素数1~4のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基或いはブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基、塩素原子或いは臭素原子等のハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アルキルカルボキシル基、カルボキシル基又はカルバモイル基である。さらにR<sup>®</sup>は、ナフタレン環に2~4ヶ置換していてもよい。

10 【0028】

ただし一般式 (14)、(15) で、nは $0\sim10$ であり、異なる数値の化合物の混合物でも良い。

【0029】2個のオキセタン環を有する化合物において、上記した化合物以外の好ましい例としては、下記一般式(16)で示される化合物がある。なお、一般式(16)において、R'は、前記一般式(2)におけるものと同様の基である。

[0030]

【化13】

【0031】 $3\sim4$ 個のオキセタン環を有する化合物としては、下記一般式(17)で示される化合物等が挙げられる。

50 [0032]

20

30

40

12

[作14] R<sup>1</sup> O R<sup>9</sup> (17)

【0033】一般式(17)において、 $R^1$ は、前記一般式(2)におけるものと同様の基であり、mは3又は 4である。 $R^3$ は、例えば、下記一般式(18)、式(19)及び式(20)で示される基等の炭素数  $1\sim 1$  2の分枝状アルキレン基、下記一般式(21)で示される基等の分枝状ポリ(アルキレンオキシ)基が挙げられる。

【0034】 【化15】

$$CH_2$$
—

 $CH_2$ —

(一般式(18)において、R<sup>™</sup> はメチル基、エチル基 又はプロピル基等の低級アルキル基である)

[0035]

【化16】

[0036] [化17]

[0037]

【化18】

(一般式(21)において、 $nは1\sim10$ の整数である)

【0038】本発明で使用するオキセタン化合物の好ま しい具体例としては、以下に示す化合物がある。 【0039】

【化19】

[0040]

【化20】

[0041]

【化21】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{C} & \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \text{CH}_2 - \text{O} \end{array}$$

[0042]

【化22】

ただし、Rはメチル基又はエチル基である

【0043】また、これら以外にも、分子量1,000~5,000程度の比較的高分子量の1~4個のオキセタン環を有する化合物も挙げられる。さらにオキセタンを含むポリマーとして、側鎖にオキセタン環を有するポリマー(例えば、K.Sato,A.Kameyama and T.Nishikubo,

50 Macromolecules, 25, 1198 (1992)を参照) 等も同様に用い

ることが出来る。なお、本発明では2種類以上のオキセ タン化合物を組み合わせて使用することができる。

【0044】さらに本発明の接着フィルムには、オキセ タン化合物(A)に、エポキシ化合物を併用してもよ い。エポキシ化合物としてはその分子中にエポキシ基を 有していれば特に制限はない。エポキシ化合物の具体例 としてはビスフェノールA、ビスフェノールAD、ビス フェノールS、ビスフェノールFもしくはハロゲン化ビ スフェノールAとエピクロルヒドリンの縮合物、フェノ ールノボラック樹脂のグリシジルエーテル、クレゾール 10 び/又は加熱することによってカチオン重合性触媒を形 ノボラック樹脂のグリシジルエーテル、ビスフェノール Aノボラック樹脂のグリシジルエーテル等が挙げられ る。エポキシ化合物の使用量は、特に制限はないが、オ キセタン化合物(A)100重量部に対し0.01~2 00重量部である。

【0045】また、接着力を向上させるため、オキセタ ン化合物(A)にシラン系カップリング剤、チタン系カ ップリング剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活 性剤、シリコーン系添加剤等を適宜加えてもよい。

【0046】本発明の構成成分である硬化剤(B)とし ては、オキセタン化合物(A)を開環重合させるもの及 び/またはオキセタン化合物に付加反応すればいかなる 化合物も用いることが可能であり、カチオン重合性触 媒、アニオン重合性触媒、潜在性カチオン重合開始剤、 潜在性アニオン重合性触媒、2官能以上のカルボン酸、 2官能以上のポリチオール、2官能以上のカルボン酸無 水物、2官能以上のフェノール化合物等が好適に用いら れる。これらは単独で、または2種類以上を組み合わせ て用いることができる。カチオン重合性触媒、アニオン 重合性触媒、潜在性カチオン重合開始剤、潜在性アニオ ン重合性触媒等の、オキセタン化合物(A)を開環重合 させる硬化剤(B')の使用量は、オキセタン化合物 (A) 100重量部に対して0.01~20重量部が好 ましく、0.1~10重量部がより好ましい。オキセタ ン化合物(A)を開環重合させる硬化剤(B')の使用 量が0.01重量部未満では硬化性が不充分な傾向があ り、20重量部を超えると接着フィルムの使用前の保存 安定性が低下する傾向がある。

【0047】また、2官能以上のカルボン酸、2官能以 上のポリチオール、2官能以上のカルボン酸無水物、2 官能以上のフェノール化合物等のオキセタン化合物

(A) と付加反応する硬化剤 (B") の使用量はオキセ タン化合物(A)100重量部に対して2~500重量 部が好ましく、50~300重量部がより好ましい。オ キセタン化合物 (A) と付加反応する硬化剤 (B") の 使用量が2重量部未満では硬化性が不充分な傾向があ り、500重量部を超えると接着フィルムの使用前の保 存安定性が低下する傾向がある。

【0048】これらの中で、オキセタン化合物(A)を 開環重合させる硬化剤 (B') として、後記する潜在性 50 カチオン重合開始剤(B1)は、保存安定性に優れる接 着フィルムが得られる点から好ましく、オキセタン化合 物(A)と付加反応する硬化剤(B")として、後記す るフェノール化合物 (B2) は、高い接続信頼性を有す る接着フィルムが得られる点から好ましい。潜在性カチ オン重合開始剤(B1)とフェノール化合物(B2)は それぞれ単独に用いることができ、または同時に用いる

14

【0049】カチオン重合性触媒は、活性光線の照射及 成し、オキセタン化合物(A)中のオキセタン環の開環 カチオン重合による硬化反応を触媒するものである。こ れらの中で、活性光線の照射及び/又は加熱することに よってカチオン重合性触媒を形成する、いわゆる潜在性 カチオン重合開始剤(B1)は、オキセタン化合物

(A) を含有する接着フィルムに配合して室温に放置す る限りにおいては長期間にわたって安定であるが、活性 光線及び/又は熱の作用で掛金が外されると、直ちにカ チオン重合性触媒を形成し、前記硬化反応を開始、促進 せしめることができる。

【0050】前記潜在性カチオン重合開始剤(B1)と しては、具体的には、以下に示すような各種オニウム塩 を挙げることができる。例えば、下記一般式(22)で 示される第四級アンモニウム塩、下記一般式(23)で 示されるホスホニウム塩および下記一般式(24)、

(25) または(26) で示されるスルホニウム塩など がある。

[0051]

こともできる。

【化23】

$$\begin{bmatrix} R^1 & R^3 \\ N & R^4 \end{bmatrix} X^{\Theta} (22)$$

【0052】 (ただし、一般式 (22) 中、R'~R' は、それぞれ、炭素原子数1~20のアルキル基、炭素 原子数3~12のアルケニル基、アリール基、アルカリ ール基、炭素原子数1~20のアルカノール基もしくは 炭素原子数5~10のシクロアルキル基であり、互いに 同一でも異なっていてもよく、また置換基を有しても有 さなくてもよい。また、R¹~R¹のうち2個は互いに 結合して、N、P、OまたはSをヘテロ原子とする複素 環を形成してもよい。さらに、Xは、BF4、PF6、 As F<sub>6</sub> , Sb F<sub>6</sub> , Sb C 1<sub>6</sub> , (C<sub>6</sub> F<sub>5</sub>) <sub>4</sub> B, SbFs (OH) \ HSO4 \ p-CH3 C6 H4 SO 』、HCO』、H2 PO4、CH3 COOおよびハロゲ ン原子からなる群より選ばれる対イオン、すなわち、1 価の陰イオンを表わす。)

[0053]

【化24】

【0054】 (ただし、一般式 (23) 中、R'~R' およびXは、それぞれ、前記一般式(22)におけるR ~R<sup>1</sup> およびXと同じである。)

[0055]

【化25】

【0056】(ただし、一般式 (24) 中、 $R^1 \sim R^3$ およびXは、それぞれ、前記一般式(22)におけるR  $\sim$ R $^{3}$  およびXと同じであり、 $R^{1}\sim$ R $^{3}$  のうち2個 は互いに結合して、N、P、OまたはSをヘテロ原子と する複素環を形成してもよい。)

[0057]

【化26】 -S-—Ar• X (25)

【0058】 (ただし、一般式 (25) 中、R'、R<sup>2</sup> およびXは、それぞれ、前記一般式(22)におけるR 、R<sup>2</sup> およびXと同じであり、R<sup>1</sup> およびR<sup>2</sup> は互い に結合して、N、P、OまたはSをヘテロ原子とする複 素環を形成してもよい。また、Arは、置換基を有して も有さなくてもよいアリール基を表わす。)

[0059]

[化27]

$$\begin{bmatrix} R^1 & \bigoplus_{S \longrightarrow Ar \longrightarrow S} & Ar \longrightarrow S & R^4 \end{bmatrix} 2X & (26)$$

【0060】(ただし、一般式(26)中、R'~R' およびXは、それぞれ、前記一般式(22)におけるR  $^{'}\sim$  R  $^{'}$  および X と同じである。また、 A  $\,$  r は、上記一 般式(25)におけるArと同じである。)

【0061】ここで、前記一般式(22)~(26)に おいて、R'、R'、R' またはR'としての前記炭素原 子数1~20のアルキル基としては、置換基を有して も、有さなくてもよい直鎖または分岐を有するアルキル 基が挙げられ、例えば、メチル基、エチル基、nープロ ピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチ ル基、tertーブチル基、nーペンチル基、イソペン チル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、イソヘキシ ル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ノニル基、デ シル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テ 50

トラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、オク タデシル基、ノナデシル基およびエイコシル基などが挙 げられる。また、前記R'、R'、R'またはR'とし ての炭素原子数3~12のアルケニル基としては、置換 基を有しても、有さなくてもよい直鎖または分岐を有す るアルケニル基が含まれ、例えば、nープロペニル基、 nーブテニル基、secープテニル基、tertーブテ ニル基、nーペンテニル基、secーペンテニル基、ヘ キセニル基、nーヘプテニル基、secーヘプテニル 10 基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基およびウン セニル基などが挙げられる。

【0062】前記R¹、R²、R³またはR⁴としての アリール基としては、例えば、置換または非置換のフェ ニル基、ナフチル基またはアントラセン基が含まれ、特 に、フェニル基が好ましい。前記 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  また はR<sup>1</sup> としてアルカリール基としては、前述の炭素原子 数1~20のアルキル基およびアリール基で構成される ものが挙げられる。また、前記 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  または R としての炭素原子数1~20のアルカノール基とし 20 ては、置換基を有しても、有さなくてもよい直鎖または 分岐を有するアルカノール基が含まれ、例えば、エタノ ール基、nープロパノール基、イソプロパノール基、n ープタノール基、secープタノール基、tertーブ タノール基、nーペンタノール基、secーペンタノー ル基、1-ヘキサノール基、1-ヘプタノール基、1-オクタノール基、1ーノナノール基、1ーデカノール 基、1-ウンデカノール基、1-ドデカノール基、1-トリデカノール基、1-テトラデカノール基、1-ペン タデカノール基、1-ヘキサデカノール基、1-ヘプタ デカノール基、1-オクタデカノール基、1-ノナデカ ノール基および1-エイコサノール基などが挙げられ る。さらにまた、前記R'、R'、R'またはR'とし ての炭素原子数5~10のシクロアルキル基としては、 置換基を有しても、有さなくてもよい分岐を有すること のあるシクロアルキル基が含まれ、例えば、シクロペン チル基、2-メチルシクロペンチル基、シクロヘキシル 基およびシクロヘプチル基などが挙げられる。一方、前 記一般式(25) および(26) において、Arとして の置換基を有しても有さなくてもよいアリール基として は、置換または非置換のフェニル基またはナフチル基が 挙げられる。

【0063】なお、前記一般式(22)~(26)にお いて、前記置換基としては、例えば、フッ素原子などの ハロゲン原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、t ertープチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、 ネオペンチル基、nーヘキシル基、イソヘキシル基、n ーヘプチル基およびnーオクチル基などの炭素原子数 1 ~8のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル 基およびシクロヘプチル基などの炭素原子数5~7のシ

クロアルキル基、またはメトキシ基、エトキシ基、プロ ポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキ シ基、secーブトキシ基、tertープトキシ基、ペ ンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、secーペン チルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ 基、ヘプチルオキシ基およびオクチルオキシ基などの炭 素原子数1~8のアルコキシ基が挙げられる。

【0064】前記一般式(22)で示される第四級アン モニウム塩としては、例えば、テトラブチルアンモニウ ムテトラフルオロボレート、テトラブチルアンモニウム 10 ヘキサフルオロホスフェート、テトラブチルアンモニウ ムハイドロゲンサルフェート、テトラエチルアンモニウ ムテトラフルオロボレート、テトラエチルアンモニウム pートルエンスルホネート、N, NージメチルーNーベ ンジルアニリニウム六フッ化アンチモン、N、Nージメ チルーNーベンジルアニリニウム四フッ化ホウ素、N. NージメチルーNーベンジルピリジニウム六フッ化アン チモン、N, NージエチルーNーベンジルトリフルオロ メタンスルホン酸、N, N-ジメチル-N-(4-メト キシベンジル)ピリジニウム六フッ化アンチモン、N, N-ジエチル-N-(4-メトキシベンジル)トルイジ ニウム六フッ化アンチモンなどを挙げることができる。 前記一般式(23)で示されるホスホニウム塩の具体例 としては、例えば、エチルトリフェニルホスホニウム六 フッ化アンチモン、テトラブチルホスホニウム六フッ化 アンチモンなどを挙げることができる。

【0065】そして、前記一般式(24)、(25)ま たは(26)で示されるスルホニウム塩としては、例え ば、トリフェニルスルホニウム四フッ化ホウ素、トリフ ェニルスルホニウム六フッ化アンチモン、トリフェニル スルホニウム六フッ化砒素、トリ(4-メトキシフェニ ル)スルホニウム六フッ化砒素、ジフェニル(4-フェ ニルチオフェニル)スルホニウム六フッ化砒素、アデカ オプトンSP-150(旭電化工業株式会社製、対イオ ン: PF。)、アデカオプトンSP-170(旭電化工 業株式会社製、対イオン: S b F。)、アデカオプトン CP-66 (旭電化工業株式会社製、対イオン:SbF 。)、アデカオプトンCP-77(旭電化工業株式会社 製、対イオン:SbF。)、サンエイドSI-6OL (三新化学工業株式会社製、対イオン: SbF6)、サ ンエイドSI-80L(三新化学工業株式会社製、対イ オン: SbF。)、サンエイドSI-100L(三新化 学工業株式会社製、対イオン: SbF。)、サンエイド SI-150(三新化学工業株式会社製、対イオン: S bF<sub>6</sub>) CYRACURE UVI-6974 (ユニ オン・カーバイド社製、対イオン:SbF。)、СҮR ACURE UVI-6990 (ユニオン・カーバイド 社製、対イオン: PF。)、UVI-508 (ゼネラル ・エレクトリック社製)、UVI-509(ゼネラル・ エレクトリック社製)、FC-508(ミネソタ・マイ 50 ニング・アンド・マニファクチュアリング社製)、FC -509 (ミネソタ・マイニング・アンド・マニファク チュアリング社製)、CD-1010(サートマー社 製)、CD-1011(サートマー社製)およびCIシ リーズ(日本曹達株式会社製、対イオン:PF。、Sb

18

【0066】さらに、前記潜在性カチオン重合開始剤 (B1) として、下記一般式 (27) で示されるジアゾ ニウム塩や下記一般式(28)で示されるヨードニウム 塩も使用することができる。

F<sub>6</sub>) などを挙げることができる。

[0067]

【化28】

$$A_{\mathbf{r}} \xrightarrow{\qquad \qquad } N \equiv N^{\bullet} X \qquad (27)$$

【0068】 (ただし、一般式 (27) 中、Arおよび Xは、それぞれ、前記一般式(25)におけるArおよ び前記一般式(22)におけるXと同じである。)

[0069]

【化29】

20

$$\begin{array}{ccc}
R^5 & \bigoplus & \bigoplus \\
I & X & (28)
\end{array}$$

【0070】(ただし、一般式(28)中、Xは、上記 一般式(22)におけるXと同じであり、R<sup>5</sup> およびR

は、互いに同一でも異なっていてもよく、また置換基 を有しても有さなくてもよいアリール基である。) 【0071】ここで、前記一般式(27)および(2 8) において、Arとしての置換基を有しても有さなく てもよいアリール基、および、Xとしての1価の陰イオ ンの具体例としては前述の通りである。また、R<sup>5</sup> およ びR<sup>6</sup>としての置換基を有しても有さなくてもよいアリ ール基としては、例えば、置換または非置換のフェニル 基、ナフチル基またはアントラセン基が挙げられ、特 に、フェニル基が好ましい。置換基としては、例えば、 フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハ ロゲン原子、メチル基、エチル基、nープロピル基、イ ソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、te rtーブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、ネ オペンチル基、nーヘキシル基、イソヘキシル基、nー ヘプチル基および n ーオクチル基などの炭素原子数 1 ~ 8のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基 およびシクロヘプチル基などの炭素原子数5~7のシク ロアルキル基、またはメトキシ基、エトキシ基、プロポ

キシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ

基、secーブトキシ基、tertーブトキシ基、ペン

チルオキシ基、イソペンチルオキシ基、secーペンチ

基、ヘプチルオキシ基およびオクチルオキシ基などの炭

ルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ

素原子数1~8のアルコキシ基が挙げられる。

【0072】前記一般式(27)で示されるジアゾニウ ム塩の具体例としては、アメリカン・キャン社製のAM ERICURE (対イオン: BF, ) および旭電化工業 株式会社製のULTRASET (対イオン:BF,、P F。) などを挙げることができる。また、前記一般式 (28)で示されるヨードニウム塩の具体例としては、 ジフェニルヨードニウム六フッ化砒素、ジー4ークロロ フェニルヨードニウム六フッ化砒素、ジー4ーブロムフ ェニルヨードニウム六フッ化砒素、フェニル(4ーメト キシフェニル)ヨードニウム六フッ化砒素、ゼネラル・ **エレクトリック社製のUVEシリーズ、ミネソタ・マイ** ニング・アンド・マニファクチュアリング社製のFCシ リーズ、東芝シリコーン社製のUV-9310C(対イ オン: S b F。) およびローヌプーラン社製のPhotoini tiator 2 0 7 4 (対イオン: (C<sub>6</sub> F<sub>5</sub>), B) などを 挙げることができる。

【0073】潜在性カチオン重合開始剤(B1)の使用 量は、オキセタン化合物(A)100重量部に対して 0.01~20重量部が好ましく、0.1~10重量部 がより好ましい。潜在性カチオン重合開始剤(B1)の 使用量が0.01重量部未満では硬化性が不充分な傾向 があり、20重量部を超えると接着フィルムの使用前の 保存安定性が低下する傾向がある。

【0074】フェノール化合物(B2)としては、その 分子中に2個以上のフェノール構造を有しているフェノ ール樹脂を用いることができる。このような樹脂として は例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボ ラック樹脂、ビスフェノールAノボラック樹脂、ポリー pービニルフェノール、フェノールアラルキル樹脂等が 挙げられる。フェノール樹脂の使用量は、オキセタン化 合物(A)100重量部に対して2~500重量部が好 ましく、50~300重量部がより好ましい。フェノー ル化合物(B2)の使用量が2重量部未満では硬化性が 不充分な傾向があり、500重量部を超えると接着フィ ルムの使用前の保存安定性が低下する傾向がある。

【0075】本発明の硬化剤(B)として、オキセタン 化合物(A)と付加反応する硬化剤(B")を用いる場 合、さらに硬化促進剤を添加してもよい。硬化促進剤と しては、イミダゾール類、ジシアンジアミド誘導体、ジ カルボン酸ジヒドラジド、トリフェニルホスフィン、テ 40 トラアルキルアンモニウムハライド類(アルキル=C・  $\sim C_{\epsilon}$ ,  $N \ni I \models F$ ,  $C_{1}$ ,  $B_{r}$ , I),  $F \vdash F \models F$ キルホスホニウムハライド類 (アルキル=C<sub>1</sub>~C<sub>8</sub>, ハ ライド=F, C1, Br, I)、テトラフェニルホスホ ニウムハライド類(ハライド=F, C1, Br, I)、 ベンジルトリアルキルアンモニウムハライド類(アルキ  $\nu = C_1 \sim C_8$ ,  $\nu = \Gamma$ エチルー4ーメチルイミダゾールーテトラフェニルボレ ート、1,8ージアザビシクロ(5,4,0)ウンデセ ンー7ーテトラフェニルボレート等が挙げられる。ま

た、前記潜在性カチオン重合開始剤 (B1) も用いるこ とができる。硬化促進剤を用いる場合のその配合量はオ キセタン化合物100重量部に対して0.01~20重 量部が好ましく、0.1~10重量部がより好ましい。 潜在性カチオン重合開始剤(B1)の使用量がO.01 重量部未満では実質的な添加効果が観察されない傾向が あり、20重量部を超えると接着フィルムの使用前の保 存安定性が低下する傾向がある。

【0076】本発明におけるポリイミド樹脂(C)は、 10 その分子中にイミド結合を有していれば特に制限はな く、いかなる樹脂も用いることができる。本発明におけ るポリイミド樹脂(C)の数平均分子量は、5,000 ~300,000とすることが好ましく、10.000 ~150,000とすることがより好ましい。この数平 均分子量が、5,000未満では、接着フィルムを用い て接着した場合に機械的強度が低下する傾向があり、3 00,000を超えると、フィルム形成性が低下する傾 向がある。なお、数平均分子量は、ゲルパーミエーショ ンクロマトグラフィー法により測定し、標準ポリスチレ ン検量線を用いて換算した値である。これらの中で、以 下に示すテトラカルボン酸二無水物(C')と、ジアミ ン(C")から合成されるポリイミド樹脂(C)は、接 着フィルム中に用いた場合、せん断接着力に優れること から好ましい。

【0077】本発明のポリイミド樹脂(C)の原料とし て用いられる、一般式 (1) のテトラカルボン酸二無水 物(C')としては、nが2~5のとき、1,2-(エ チレン) ビス(トリメリテート二無水物)、1,3-(トリメチレン) ビス (トリメリテート二無水物)、 1, 4-(テトラメチレン) ビス(トリメリテート二無 水物)、1,5-(ペンタメチレン)ビス(トリメリテ ート二無水物)、nが6~20のとき、1,6-(ヘキ サメチレン) ビス(トリメリテート二無水物)、1、7 - (ヘプタメチレン) ビス (トリメリテート二無水 物)、1,8-(オクタメチレン)ビス(トリメリテー ト二無水物)、1,9-(ノナメチレン)ビス(トリメ リテート二無水物)、1、10-(デカメチレン)ビス (トリメリテート二無水物)、1,12-(ドデカメチ レン) ビス(トリメリテート二無水物)、1,16-(ヘキサデカメチレン) ビストリメリテート二無水物、 1, 18- (オクタデカメチレン) ビス (トリメリテー ト二無水物)等があり、これら2種以上を併用してもよ

【0078】上記テトラカルボン酸二無水物(C') は、無水トリメリット酸モノクロライド及び対応するジ オールから合成することができる。また、全テトラカル ボン酸二無水物に対して上記テトラカルボン酸二無水物 (C') の含まれる量が、70モル%以下であると、接 着フィルムの接着時の温度が高くなり好ましくない。

【0079】一般式(1)のテトラカルボン酸二無水物

50

30

(C') と共に使用できるテトラカルボン酸無水物とし ては、例えば、ピロメリット酸二無水物、3,3', 4. 4'ージフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2′、3、3′ージフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プ ロパン二無水物、2、2ービス(2、3ージカルボキシ フェニル)プロパン二無水物、1,1-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル) エタン二無水物、1,1-ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) エタン二無水物、ビ ス(2.3ージカルボキシフェニル)メタン二無水物、 ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) メタン二無水 物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)スルホンニ 無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸 二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)エー テル二無水物、ベンゼンー1,2,3,4ーテトラカル ボン酸二無水物、3,4,3',4'-ベンゾフェノン テトラカルボン酸二無水物、2,3,2',3ーベンゾ フェノンテトラカルボン酸二無水物、2,3,3', 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、1. 2、5、6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、 2, 3, 6, 7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水 物、1,2,4,5ーナフタレンーテトラカルボン酸二 無水物、1,4,5,8ーナフタレンーテトラカルボン 酸二無水物、2,6-ジクロルナフタレン-1,4, 5.8-テトラカルボン酸二無水物、2,7-ジクロル ナフタレンー1、4、5、8ーテトラカルボン酸二無水 物、2, 3, 6, 7-テトラクロルナフタレン-<math>1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレ ン-1,8,9,10-テトラカルボン酸二無水物、ピ ラジンー2,3,5,6ーテトラカルボン酸二無水物、 チオフェンー2,3,4,5ーテトラカルボン酸二無水 物、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸 二無水物、3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラカル ボン酸二無水物、2,3,2',3'-ビフェニルテト ラカルボン酸二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフ ェニル)ジメチルシラン二無水物、ビス(3,4-ジカ ルボキシフェニル)メチルフェニルシラン二無水物、ビ ス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン 二無水物、1,4-ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ルジメチルシリル)ベンゼン二無水物、1,3ービス (3, 4-i)テトラメチルジシクロヘキサン二無水物、pーフェニル ビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)、 【0080】エチレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2.3.4ーブタンテトラカルボン酸二無水物、デカヒ ドロナフタレンー1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二 無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタレンー1, 2, 5, 6ーテトラカル ボン酸二無水物、シクロペンタン-1、2、3、4-テ

トラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3,4,5 50

ーテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロ ブタンテトラカルボン酸二無水物、ビス(エキソービシ クロ〔2, 2, 1〕ヘプタン-2, 3-ジカルボン酸無 水物) スルホン、ビシクロー(2,2,2)ーオクト (8) -エン2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水 物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)へ キサフルオロプロパン二無水物、2,2ービス〔4-(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]ヘキサ フルオロプロパン二無水物、4,4'ービス(3,4-ジカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフィド二無水 物、1,4-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソ プロピル)ベンゼンビス(トリメリット酸無水物)、 1.3-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロ ピル)ベンゼンビス(トリメリット酸無水物)、5-(2, 5-ジオキソテトラヒドロフリル) -3-メチル -3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸無水物、 テトラヒドロフランー2, 3, 4, 5ーテトラカルボン 酸二無水物等があり、2種類以上を混合して用いてもよ

【0081】本発明のポリイミド樹脂(C)のもう一つ の原料として用いられる、ジアミン(C")としては、 1,2-ジアミノエタン、1,3-ジアミノプロパン、 1, 4-ジアミノブタン、1, 5-ジアミノペンタン、 1, 6ージアミノヘキサン、1, 7ージアミノヘプタ ン、1、8-ジアミノオクタン、1、9-ジアミノノナ ン、1,10ージアミノデカン、1,11ージアミノウ ンデカン、1,12-ジアミノドデカン等の脂肪族ジア ミン、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミ ン、p-フェニレンジアミン、3,3'ージアミノジフ ェニルエーテル、3,4'ージアミノジフェニルエーテ ル、4, 4' - ジアミノジフェニルエーテル、<math>3, 3'ージアミノジフェニルメタン、3,4'ージアミノジフ ェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、 3.3'ージアミノジフェニルジフルオロメタン、3, 4'ージアミノジフェニルジフルオロメタン、4,4' ージアミノジフェニルジフルオロメタン、3,3'ージ アミノジフェニルスルホン、3,4'ージアミノジフェ ニルスルホン、4, 4' ージアミノジフェニルスルホ ン、3、3′ージアミノジフェニルスルフイド、3、 4'ージアミノジフェニルスルフイド、4,4'ージア ミノジフェニルスルフイド、

【0082】3、 $3'-\vec{y}$ アミノジフェニルケトン、3、 $4'-\vec{y}$ アミノジフェニルケトン、4、 $4'-\vec{y}$ アミノジフェニルケトン、2、 $2-\vec{y}$ ス(3 $-\vec{y}$ 3)プロパン、2、 $2'-(3,4'-\vec{y}$ 7)アミノジフェニル)プロパン、2、 $2-\vec{y}$ 3、 $4'-\vec{y}$ 7、22、 $2-\vec{y}$ 3、 $4'-\vec{y}$ 7、23、 $4'-\vec{y}$ 7、24、24、25 ( $3-\vec{y}$ 8) スキサフルオロプロパン、2、 $2-(3,4'-\vec{y}$ 9)、2、 $2-\vec{y}$ 7、25 ( $4-\vec{y}$ 8) スキサフルオロプロパン、1、27 ( $4-\vec{y}$ 8) スキサフルオロプロパン、1、27 ( $4-\vec{y}$ 8) スキサフルオロプロパン、1、27 ( $4-\vec{y}$ 8) スキサフルオロプロパン、1、27 ( $4-\vec{y}$ 9) スキサフルオロプロパン、1、 $2-\vec{y}$ 9 ( $4-\vec{y}$ 9) スキサフルオロプロパン、1 ( $4-\vec{y}$ 9 ( $4-\vec{y}$ 9) スキサフルオロプロパン、1 ( $4-\vec{y}$ 9 (4-

3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビスア ニリン、3,4'-(1,4-フェニレンビス(1-メ チルエチリデン)) ビスアニリン、4,4'-(1,4 **-フェニレンビス(1 -メチルエチリデン))ビスアニ** リン、2、2ービス(4ー(3ーアミノフェノキシ)フ ェニル)プロパン、2,2ービス(4ー(4ーアミノフ ェノキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、2, 2ービス(4-(4-アミノフェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルフイド、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルフイド、ビス (4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、 ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルホ ン等の芳香族ジアミンを挙げることができる。

23

【0083】テトラカルボン酸二無水物(C')とジアミン(C")の縮合反応は、有機溶媒中で行うこともできる。この場合、テトラカルボン酸二無水物(C')1 モル当量に対し、ジアミン(C")が0.5~2モル当量用いることが好ましく、0.75~1.5モル当量用いることが極めて好ましく、0.8~1.2モル当量用いることが極めて好ましい。テトラカルボン酸二無水物(C')1モル当量に対し、ジアミン(C")が0.5モル当量未満または2.0モル当量を超える場合、ポリイミド樹脂(C)の数平均分子量が低くなる傾向がある。テトラカルボン酸二無水物(C')とジアミン(C")と有機溶媒の添加順序は任意である。用いる有機溶媒としては、ジメチルアセトアミド、ジメチルホル

【0084】反応温度は80℃以下、好ましくは0~50℃である。反応が進行するにつれ反応液の粘度が徐々に上昇する。この場合、ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸が生成する。

ムアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスル

ホキシド、ヘキサメチルホスホリルアミド、mークレゾ

ール、oークロルフェノール等がある。

【0085】ポリイミドは、上記反応物(ポリアミド酸)を脱水閉環させて得ることができる。脱水閉環は120℃~250℃で熱処理する方法や化学的方法を用いて行うことができる。120℃~250℃で熱処理する方法の場合、脱水反応で生じる水を系外に除去しながら行うことが好ましい。この際、ベンゼン、トルエン、キシレン等を用いて水を共沸除去してもよい。なお、本発明においてポリイミド樹脂(C)とは、ポリイミド及びその前駆体を総称する。ポリイミドの前駆体には、ポリアミド酸のほか、ポリアミド酸が部分的にイミド化したものがある。

【0086】化学的方法で脱水閉環させる場合は、閉環

剤として無水酢酸、無水プロピオン酸、無水安息香酸の酸無水物、ジシクロヘキシルカルボジイミド等のカルボジイミド化合物等を用いる。このとき必要に応じてピリジン、イソキノリン、トリメチルアミン、アミノピリジン、イミダゾール等の閉環触媒を用いてもよい。閉環剤又は閉環触媒は、テトラカルボン酸二無水物(C')1モルに対し、それぞれ1~8モルの範囲で使用するのが好ましい。

24

【0087】ポリイミド樹脂(C)を用いる場合、その 使用量は、オキセタン化合物(A)100重量部に対し て0.01~10000重量部用いることが好ましく、 0. 5~5000重量部用いることがより好ましく、1 ~1000重量部用いることが最も好ましい。ポリイミ ド樹脂(C)の使用量が0.01重量部未満では実質的 な添加効果が発現されない傾向があり、また10000 重量部以上ではフィルム形成性が低下する傾向がある。 【0088】本発明で用いる導電性フィラー(D)は、 接着フィルムに導電性を付与する目的で添加するもので あり、金粉、銀粉、銅粉、ステンレス粉等の導電性金属 粉体や、カーボンブラック等が挙げられる。これらは単 独に、又は2種以上混合して用いる。 導電性フィラー (D) の添加量は、オキセタン化合物(A) 100重量 部に対し0~8000重量部、好ましくは10~400 0重量部である。8000重量部を超えると接着性が低 下する傾向がある。

【0089】また、絶縁性フィラー(E)を添加するこ ともできる。絶縁性フィラー(E)の具体例としては、 シリカ粉、アルミナ粉、チタニア、ガラス、酸化鉄、石 英粉、マグネシア、炭化ケイ素、窒化ホウ素等の粒子状 の無機充填剤(フィラー)、MBS(メチルメタクリレ ートープタジエンースチレン)樹脂、シリコーン樹脂、 フッ素樹脂等の有機微粒子等が挙げられる。絶縁性フィ ラー(E)の添加量は、オキセタン化合物(A)100 重量部に対し0~8000重量部、好ましくは10~4 000重量部である。8000重量部を超えると接着性 が低下する傾向がある。さらに、導電性フィラー(D) と絶縁性フィラー(E)を併用して用いる場合、その使 用量はオキセタン化合物(A)100重量部に対し、導 電性フィラー(D)と絶縁性フィラー(E)の合計で1 ~8000重量部、好ましくは10~4000重量部で ある。導電性フィラー(D)と絶縁性フィラー(E)の 合計が1重量部未満では、接着フィルムに導電性を付与 したい場合においても充分な導電性が得られなくなる傾 向があり、8000重量部を超えると接着性が低下する 傾向がある。

【0090】本発明で用いる溶媒(F)は接着フィルムを製造するに当たり、各成分を混合、分散させることができるものを好適に選択できる。溶媒(F)の具体例としてはジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジエチ

レングリコールジメチルエーテル、トルエン、ベンゼ ン、キシレン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラ ン、エチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、 ブチルセロソルブ、ジオキサン等が挙げられる。溶媒

(F) は単独でまたは2種類以上を混合して用いること ができる。溶媒(F)の沸点は50℃~300℃が好ま しく、70~250℃がより好ましい。溶媒(F)の沸 点が50℃未満では後記する接着フィルムの製造時に溶 媒が飛散しやすく、接着フィルム表面のみが乾燥する、 いわゆる革張りが発生しやすくなる傾向があり、また3 00℃を超える場合にはフィルム作製時に溶媒が飛散し にくくなる傾向がある。

【0091】本発明の接着フィルムの製造方法は、まず 各成分を混合しペースト状混合物を作製し、これを例え ばポリエステル製フィルム等のベースフィルム上に均一 に塗布し、溶媒(F)を用いた場合には、使用した溶媒 が充分に揮散する条件、すなわち、おおむね60~20 0℃の温度で、0.1~30分間加熱して行われる。接 着フィルムは、通常、使用時にベースフィルムを除去し て接着に用いる。本発明の接着フィルムの製造における ペースト状混合物の作製方法は特に制限はなく、たとえ ば、オキセタン化合物(A)と硬化剤(B)、必要に応 じて溶媒(F)、添加剤を加え、通常の攪拌機、らいか い機、三本ロール、ボールミルなどの分散機を適宜組み 合せて混練する方法、ポリイミド樹脂(C)を溶媒

(F) に溶解し、次いで必要に応じて、導電性フィラー (D) 及び/または絶縁性フィラー(E)、添加剤を加 え、通常の攪拌機、らいかい機、三本ロール、ボールミ ルなどの分散機を適宜組み合せて混練し、さらにオキセ タン化合物(A)と硬化剤(B)を加えて混合する方 法、ポリイミド樹脂(C)をオキセタン化合物(A)に 溶解し、次いで必要に応じて、導電性フィラー(D)及 び/または絶縁性フィラー(E)、添加剤を加え、通常 の攪拌機、らいかい機、三本ロール、ボールミルなどの 分散機を適宜組み合せて混練し、さらに硬化剤(B)を 加えて混合する方法、ポリイミド樹脂(C)、オキセタ ン化合物(A)、必要に応じて導電性フィラー(D)及 び/または絶縁性フィラー(E)、溶媒(F)を混練 し、さらに硬化剤(B)を加えて混合する方法、ポリイ ミド樹脂(C)、オキセタン化合物(A)、硬化剤 (B) に必要に応じて、導電性フィラー (D) 及び/ま

たは絶縁性フィラー(E)、溶媒(F)を混練する方法 等が挙げられる。本発明の接着フィルムの製造における ペースト状混合物の作製方法において、オキセタン化合 物(A)に、室温で液状のオキセタン化合物を用いる と、溶媒(F)を用いなくともペースト状混合物を作製 することができ、このようにして得られたペースト状混 合物も同様に接着フィルムの製造に用いることができ る。

【0092】本発明で得られた接着フィルムは、IC、

LSI等の半導体素子のリードフレーム、セラミックス 配線板、ガラスエポキシ配線板、ガラスポリイミド配線 板等の支持部材の接着に用いられる。

【0093】本発明の接着フィルムは、例えば、ICや LSI等の半導体素子とリードフレームとを接着する場 合、次の様な方法で接着することができる。第一に、接 着フィルムをテープリボン状に形成し、これを半導体素 子の大きさに合わせて切断し、リードフレーム等の支持 部材と半導体素子の間に挟み込んで、加熱接着させる方 法がある。この方法で接着する場合には、例えば半田リ ボン用のダイボンディング装置等を応用した装置で接着 させることができる。

【0094】第二に、接着フィルムをまずリードフレー ム等の支持部材に形成しておき、次に半導体素子を加熱 接着させる方法がある。リードフレームに接着フィルム を形成するには、接着フィルムを半導体素子の大きさに 合わせて切断し、加熱して貼り付ける方法あるいは溶媒 を塗布して貼り付ける方法等がある。また、接着フィル ムのワニスをリードフレーム上に印刷塗布する方法で形 成させることもできる。リードフレームに接着フィルム を形成した後、半導体素子を接着するには、例えば、従 来、銀ペーストで用いられていたダイボンディング装置 等を応用した装置で接着させることができる。

【0095】第三に、接着フィルムをウェハ裏面に形成 しておき、次にダイシング工程でウェハ及び接着フィル ムを切断し、リードフレームに接着する方法がある。ウ ェハ裏面に接着フィルムを形成するには、接着フィルム を加熱して貼り付ける方法あるいは溶媒を塗布して貼り 付ける方法等がある。また、接着フィルムのワニスをウ ェハ裏面に印刷塗布あるいはスピンコートする方法で形 成させることもできる。ウェハ裏面に接着フィルムを形 成した後、半導体素子を接着するには、例えば、従来、 銀ペーストで用いられていたダイボンディング装置等を 応用した装置で接着させることができる。上記接着を行 う際の接着温度は、60~350℃が好ましく、60~ 300℃がより好ましく、60~250℃が最も好まし い。この温度が60℃未満では、接着にかかる時間が長 くなり、生産性が低下する傾向があり、350℃以上で は長期接着信頼性が低下する傾向がある。また、この際 40 の接着時間は特に制限はないが、おおむね0.1秒~3 0分である。上記接着を行なう際の圧着の圧力は接着す る被着体の種類によって調節することができるが、おお むね0. 1KPa~10MPaである。

【0096】上記の方法の他に、ダイシング工程で用い られる粘着性のダイシングフィルムの上に、接着フィル ムを形成させておき、これにウェハを貼り付けた後、ダ イシング工程で半導体素子と接着フィルムを切断し、リ ードフレームに貼り付ける方法等があるが、本発明の接 着フィルムは、上記に例示したいずれの方法に限定され 50 るものではない。また、上記の接着を行なう際に、加熱

\* ト二無水物) 43.8g(0.1モル)を加えた。5℃ 以下で5時間反応させ、無水酢酸20.4g(0.2モ ル) 及びピリジン15.8g(0.2モル) を加え、1

時間室温で攪拌した。この反応液を水中に注ぎ、沈澱し たポリマーを濾過により採り、乾燥して数平均分子量5

28

0,000のポリイミド樹脂(C-2)を得た。

【0099】(合成例3)温度計、攪拌機、塩化カルシ ウム管を備えた500mlの四つ口フラスコに、2,2 ービス(4ーアミノフェノキシフェニル)プロパン 3 2. 8g(0.08モル)、3,3',5,5'ーテト ラメチルー 4 , 4' ージアミノジフェニルメタン 5 . 08g(0.02モル)及びジメチルアセトアミド10 0 gをとり、攪拌した。ジアミンの溶解後、フラスコを 氷浴中で冷却しながら、1,10-(デカメチレン)ビ ス(トリメリテート二無水物) 41.8g(0.08モ ル)及びベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物6. 44g(0.02モル)を少量ずつ添加した。添加終了 後、氷浴中で3時間、更に室温で4時間反応させた後、 無水酢酸25.5g(0.25モル)及びピリジン1 9.8g(0.25モル)を添加し、2時間室温で攪拌 した。その反応液を水中に注ぎ、沈澱したポリマーを濾 過により採り、乾燥して数平均分子量60,000のポ

【0100】 (実施例1~8、比較例1) 表1に示す配 合表に従い、ポリイミド樹脂(C)を溶媒(F)に溶解 し、次いで、導電性フィラー (D) 及び/または絶縁性 フィラー(E)を加え、らいかい機で10分間混練し、 さらにオキセタン化合物(A)と硬化剤(B)を加えて 3枚羽攪拌装置で10分間混合してペースト状混合物を 30 調合した。

リイミド樹脂(C-3)を得た。

[0101] 【表1】

圧着する前、加熱圧着と同時、加熱圧着の後にカーボン アーク、水銀蒸気アーク、キセノンアーク、写真用フラ ッド電球、太陽ランプ、その他の光源から発生する活性 光線を接着フィルムに照射することもできる。加熱圧着 と同時、加熱圧着の後に、活性光線を接着フィルムに照 射する場合、被着体が活性光線を透過する場合にはどの ような方向から光照射しても良く、被着体が活性光線を 透過しない場合には被着体同士の隙間から接着フィルム に活性光線を照射することができる。活性光線を接着フ イルムに照射すると、圧着時の加熱温度を下げたり、圧 10 着時間をさらに短縮することができることから好まし い。

#### [0097]

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明す る。

(合成例1)温度計、攪拌機及び塩化カルシウム管を備 えた500mlの四つ口フラスコに、2,2-ビス(4 ーアミノフェノキシフェニル)プロパン41g(0.1 モル) 及びジメチルアセトアミド150gをとり、攪拌 した。ジアミンの溶解後、フラスコを氷浴中で冷却しな 20 がら、1,2-(エチレン)ビス(トリメリテート二無 水物) 41g(0.1モル)を少量ずつ添加した。室温 で3時間反応させたのち、キシレン30gを加え、N2 ガスを吹き込みながら150℃で加熱し、水と共にキシ レンを共沸除去した。その反応液を水中に注ぎ、沈澱し たポリマーを濾過により採り、乾燥して数平均分子量4 0,000のポリイミド樹脂(C-1)を得た。

【0098】(合成例2)温度計、攪拌機及び塩化カル シウム管を備えた500mlの四つロフラスコに、ビス (4-(3-アミノフェノキシ) フェニル) スルホン 43.2g(0.1モル)及びN-メチル-2-ピロリ ドン 150gをとり攪拌した。ジアミンの溶解後、室 温で、1、4ー (テトラメチレン) ビス

				メリテー*					
項目	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	H 鞍偏1
ホ・リイミト・	C-1	C-1	C-2	C-2	C-3	C-3	C-1	C-1	C-1
(c)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
オキセタン化	XDO	B1	XDO	XDO	XDQ	B2	XDO	XDO	
合物(D)	50	50	50	50	50	50	40	50	
硬化剤	SI100L	SHOOL	H−1	SI100L	H-1	SI100L	SILOOL	SP-170	SI100L
(B)	2	2	32	2	32	3	2	2	2
導電性	TCG	_	TCG-1	TCG-1	TCG-1		TCG-1	TCG-1	
7( <del>7 (</del> D)	100		100	50	_ 100		100	100	
絶縁性	-	シリカ	-	シリカ		アルミナ			
フィラー(E)		60		50		60			
溶媒(F)	DMAc	DMAc	NMP	NMP	DMF	DMF	DMAc	DMAc	DMAc
l	100	100	100	100	100	100	100	100	100
硬化促	-	-	2MIZ		2MIZ	_	_		
進剤			1		1				
その他	-	_		_	_		ESCN-195		
添加剂							10		Į.

【0102】なお、表1において種々の記号は下記の意 味である(配合量は、重量部)。

ルー3ーオキセタニルメトキシ) メチル] ベンゼン B1:1, 2-ビス(3-エチル-3-オキセタニルメ XDO:東亜合成株式会社、1. 4-ビス [(3-エチ 50 トキシ) - 4 - tertブチルベンゼン

B2:1, 3-ビス(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ) ベンゼン

SI100L:三新化学工業株式会社、サンエイドSI

-100L、カチオン性潜在性硬化剤

SI150:三新化学工業株式会社、サンエイドSI-

150、カチオン性潜在性硬化剤

SP-170:旭電化工業株式会社、アデカオプトンS

P-170、カチオン性潜在性硬化剤

H-1:明和化成株式会社、フェノールノボラック(O

H 当量 1 0 6)

TCG-1:徳力化学株式会社、銀粉

DMAc:ジメチルアセトアミド

NMP: N-メチルピロリドン

DMF:ジメチルホルムアミド

2MIZ: 2-メチルイミダゾール

ESCN-195:日本化薬株式会社、クレゾールノボ

ラック型エポキシ(エポキシ当量200)

【0103】このペースト状混合物を $30\sim50\mu$ mの厚さにポリエステルフィルム上に塗布し、80%で10

分、つづいて150℃で30分加熱し接着フィルムを得\*20

\*た。

【0104】(剪断接着力試験)実施例1~8、比較例 1の各組成で得られた接着フィルムについて、剪断接着 力試験を行った。なお、試験方法は、接着フィルムを 4 ×4mmの大きさに切断し、これを4×4mmのシリコ ンチップと銀メッキ付リードフレームの間に挟み、9. 806N(1000g)の荷重をかけて、120℃、5 秒間圧着させて、接着体を作製した。実施例8の組成で 得られた接着フィルムは、4×4mmの大きさに切断 10 し、これを銀メッキ付リードフレームにはりつけ、50 OW超高圧水銀灯を用いて、100mJ/cm2で活性光線を 照射した。その後、4×4mmのシリコンチップを乗せ て、9.806N(1000g)の荷重をかけて、11 0℃、3秒間圧着させて、接着体を作製した。剪断接着 力試験は、得られた被着体を用い、室温(25℃)で5 O N/chipの荷重をかけた場合、また、350℃で10 N/chipの荷重をかけ、チップの剥離状態を観察し行な った。結果を表2に示した。

[0105]

【表2】

2 0 73 73	とりしが開放し込むということ こここ								
測定温度	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	比較例
	1	2	3	4	5	6	7	8	1
室温	0	0	0	0	0	0	0	0	×
350℃	0	0	0	0	0	0	0	0	×

30

室温:室温にて50N/chipの荷重をかけてチップが剥離しない=○

室温にて50N/chipの荷重をかけてチップが剥離する =×

350℃:350℃にて10N/chipの荷重をかけてチップが剥離しない=○

350℃にて10N/ chipの荷重をかけてチップが剥離 する=×

【0106】本発明の構成成分であるオキセタン化合物(A)、硬化剤(B)を含む実施例1~8の接着フィルムは、従来の接着フィルムよりも低温短時間での接着が可能であり、剪断接着力試験の結果も良好であった。これに対して本発明の必須成分であるオキセタン化合物

(A) を用いなかった比較例 1 の接着フィルムは、剪断 40 接着力試験の結果、剥離してしまった。

### [0107]

【発明の効果】請求項1記載の発明は、低温接着性に優れ、42アロイリードフレームや、銅リードフレームにも好適に使用でき、更に絶縁性支持基板にも好適に使用

できる接着フィルムを提供するものである。請求項2、 3記載の発明は、請求項1記載の発明の効果に加えてせ ん断接着力に優れる接着フィルムを提供するものであ る。請求項4、5記載の発明は、請求項1~3記載の発 明の効果に加えて熱膨張係数の異なる基材同士の接着に 優れる接着フィルムを提供するものである。請求項6、 7記載の発明は、請求項1~5記載の発明の効果に加え て保存安定性に優れる接着フィルムを提供するものであ る。請求項8,9記載の発明は、請求項1~5記載の発 明の効果に加えて高い接着信頼性を付与できる接着フィ ルムを提供するものである。請求項10記載の発明は、 請求項1~9に記載の接着フィルムの製造方法を提供す るものである。請求項11記載の発明は、請求項1~9 記載の接着フィルムを用いた、半導体素子と支持部材の 接着方法を提供するものである。請求項12記載の発明 は、活性光線を接着フィルムに照射することを特徴とす る半導体素子と支持部材との接着法を提供するものであ る。

### フロントページの続き

Fターム(参考) 4J004 AA07 AA11 AA12 AB04 CA06 CC02 FA05

> 4J040 DB052 EB062 EE031 EH032 EK032 GA05 GA07 GA14 GA22 GA28 HA026 HA066

HA116 HA206 HA306 HA326 HA346 HB10 HB22 HB26

HC01 HC12 HC14 HC15 HC22

HD03 HD18 HD22 HD24 HD39

HD43 JA05 JB02 KA14 KA16

KA32 KA42 LA06 LA09 MA03

MA10 NA19 NA20 PA23 PA30

5G301 DA03 DA18 DA33 DA42 DA51

DD03 DD08